

Silicon NPN Transistor

BU106

325V / 5A

DATASHEET

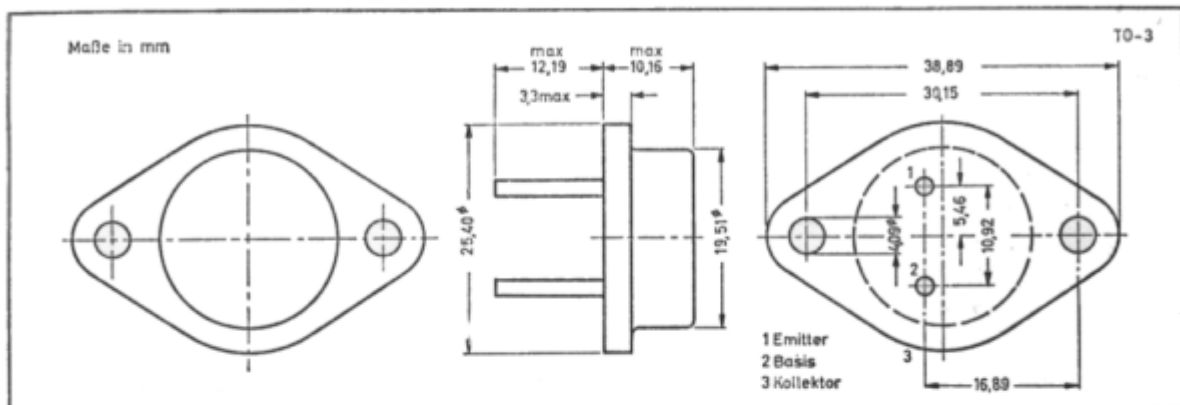
OEM – Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

BU106

NPN-Silizium-Leistungstransistor

Entwickelt für Fernsichtanwendungen

Mechanische Daten

Alle Abmessungen nach JEDEC TO-3. Der Kollektor ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden.

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung ($0 \geq U_{BE} \geq -8 \text{ V}$)	325 V
Emitter-Basis-Spannung	8 V
Kollektor-Spitzenstrom	5 A
Basis-Spitzenstrom	3 A
Gehäusetemperatur (Anwendung siehe Bem. 1)	100 °C

Elektrische Kennwerte

I_{CES}	Kollektor-Emitter-Reststrom	$U_{BE} = 0, U_{CE} = 325 \text{ V}$	(Bem. 2)	$\leq 50 \text{ mA}$
I_{EBO}	Emitter-Basis-Reststrom	$U_{EB} = 8 \text{ V}, I_C = 0$		$\leq 10 \text{ mA}$

Arbeitskennwerte

Impulstest mit $I_C = 4 \text{ A}, I_{B(\text{ein})} = 0,5 \text{ A}, I_{B(\text{aus})} = 1,0 \text{ A}$ (Bem. 1)

$U_{BE(\text{sat})}$	Kollektor-Basis-Sättigungsspannung	$\leq 1,5 \text{ V}$
$U_{CE(\text{sat})}$	Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$\leq 5 \text{ V}$
t_f	Abfallzeit des Kollektorstroms	$\leq 1 \mu\text{s}$
t_s	Speicherzeit	$\leq 3 \mu\text{s}$

Bemerkungen:

- Für Anwendungen in Horizontal-Ablenk-Endstufen.
- mpulstest; Tastverhältnis $\leq 2\%$.